

PRESSEINFORMATION

PRESSEINFORMATION

08. Februar 2024 || Seite 1 | 3

Richtfest für das Center for Advanced CMOS and Heterointegration Saxony

Das Center for Advanced CMOS and Heterointegration Saxony (kurz: CEASAX) feiert das Richtfest seines neuen Bürogebäudes. CEASAX ist ein Leuchtturm der Halbleiterforschung und gründet sich auf die Bündelung der Kompetenzen des Fraunhofer IPMS und des Fraunhofer IZM-ASSID. Die Institute bieten hier die komplette Wertschöpfungskette in der 300-mm-Mikroelektronik und damit die Voraussetzung für Hightech-Forschung für Zukunftstechnologien im Land Sachsen.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die Institutsleiter des Fraunhofer IPMS, Prof. Dr. Harald Schenk und Prof. Dr. Hubert Lakner. Auch die Standortleiterin des Fraunhofer IZM-ASSID, Dr. Manuela Junghänel, war vor Ort und sieht in der Stärkung der gemeinsamen Fraunhofer-Kompetenz am gemeinsam genutzten Gebäude eine große Chance zur Weiterentwicklung der 300-mm-Wafer-Technologien. Lakner hebt die Bedeutung des Ausbaus für den Technologiestandort Sachsen hervor: »Im CEASAX bündeln sich die Stärken der beiden einzigen deutschen Forschungszentren für angewandte Mikroelektronikforschung, die auf Basis von 300 mm Wafer-Industriestandard forschen. Im Rahmen des European Chips Acts sind diese Stärken wichtiger denn je. Der Neubau ermöglicht uns im wahren und im übertragenen Sinne Platz für herausragende Mikroelektronikforschung.«

Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: »Die Fraunhofer-Gesellschaft ist ein wichtiger Bestandteil der sächsischen Forschungslandschaft. Gerade auch das Center Nanoelectronic Technologies steht für Kreativität, neue Ideen und Zusammenarbeit. Es ist gut, dass hier ein gemeinsamer Raum für Forschungen durch die beiden Institute IPMS und IZM-ASSID entsteht, die in der bundesweiten Forschungslandschaft eine einzigartige Kompetenz im Bereich der 300-mm-Wafer im Industriestandard haben. Die hier geleistete Arbeit wird dabei helfen, viele weitere Projekte bei uns im Silicon Saxony zu starten und erfolgreich voranzubringen. So stärken wir dauerhaft Sachsens Forschung, aber auch unsere Wirtschaft insgesamt. Genau aus diesen Gründen unterstützt der Freistaat dieses wichtige Projekt.«

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ergänzte: »Dieser entstehende Neubau und die Unterstützung von zukunftsweisenden Forschungsthemen wie der Mikroelektronik durch den Freistaat Sachsen wirken eng zusammen, wenn es darum geht, die Entwicklung in der Region voranzutreiben. Wissenschaftliche Exzellenz weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Transfer von Ergebnissen in die Praxis fest im Blick zu haben, ist uns ein zentrales Anliegen. Hierfür braucht es Raum und Kommunikation. Für beides wird der Neubau hier am Standort stehen.«

Redaktion

Dr. Anne-Julie Zichner | Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS | Telefon +49 351 8823-2604 |
Maria-Reiche-Straße 2 | 01109 Dresden | www.ipms.fraunhofer.de | anne-julie.zichner@ipms.fraunhofer.de

**FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PHOTONISCHE MIKROSYSTEME IPMS
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND
MIKROINTEGRATION, ALL SILICON SYSTEM INTEGRATION DRESDEN – ASSID**

Nach den Ansprachen folgte der traditionelle Richtspruch, bei dem symbolisch der erfolgreiche Baufortschritt gefeiert wurde.

PRESSEINFORMATION

08. Februar 2024 || Seite 2 | 3

Über das Center for Advanced CMOS and Heterointegration Saxony

Mit dem Fraunhofer IZM-ASSID und Fraunhofer IPMS, Bereich Center Nanoelectronic Technologies CNT, sind zwei bundesweit einzigartige Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Mikroelektronik in Sachsen angesiedelt. Es sind heute die beiden einzigen deutschen Forschungszentren für angewandte Mikroelektronikforschung, die auf Basis von 300 mm Wafer-Industriestandard-Equipment forschen.

Mit der Bündelung der Kompetenzen und Gründung des Centers for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony entstehen hervorragende Perspektiven, Halbleiter-Unternehmen und Systemanwender sowie Material- und Anlagenhersteller weltweit anzuziehen und an Silicon Saxony zu binden. Für Industrie- und Forschungsaufträge sind neben hervorragendem Personal und Know-how eine Ausstattung mit einem modernen Geräte- und Anlagenpark entscheidend.

Für die zukünftige Weiterentwicklung der notwendigen Kompetenzen in der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik werden die R&D-Angebote des Fraunhofer IZM-ASSID und Fraunhofer IPMS hinsichtlich der 300 mm Prozesskompetenzen so gestaltet und ausgebaut, dass die lokale und nationale Industrie von KMUs bis zu Großunternehmen (z.B. GlobalFoundries, Infineon, Bosch) von den modernsten Technologien bestmöglich profitieren kann. Die Integrationsplattform wird darüber hinaus auch in kundenspezifischen Projekten im Rahmen des Leistungszentrums »Funktionsintegration für die Mikro-/Nanoelektronik« und in der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) genutzt.

**FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PHOTONISCHE MIKROSYSTEME IPMS
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND
MIKROINTEGRATION, ALL SILICON SYSTEM INTEGRATION DRESDEN – ASSID**

Bildmaterial

PRESSEINFORMATION

08. Februar 2024 || Seite 3 | 3



*Reinraum des Center for Advanced CMOS &
Heterointegration Saxony
© Fraunhofer IPMS*



*Visualisierung für den Neubau
© heinlewischer Architekten Dresden*